

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Кафедра № 6

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель направления

д.э.н., проф.

(должность, уч. степень, звание)

В.В. Окрепилов

(инициалы, фамилия)



(подпись)

«23» июня 2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

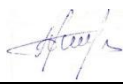
«Методы исследования с использованием сканирующей зондовой микроскопии»
(Наименование дисциплины)

Код направления подготовки/ специальности	27.03.01
Наименование направления подготовки/ специальности	Стандартизация и метрология
Наименование направленности	Цифровая метрология и стандартизация
Форма обучения	очная

Санкт-Петербург– 2022

Лист согласования рабочей программы дисциплины


Программу составил (а)

<u>Доц., к.т.н.</u> (должность, уч. степень, звание)	 (подпись, дата)	23.06.2022	<u>А.Г. Грабарь</u> (инициалы, фамилия)
--	--	------------	--


Программа одобрена на заседании кафедры № 6

«23»июня 2022 г, протокол № 17

Заведующий кафедрой № 6

<u>д.э.н., проф.</u> (уч. степень, звание)	 (подпись, дата)	23.06.2022	<u>В.В. Окрепилов</u> (инициалы, фамилия)
---	--	------------	--

Ответственный за ОП ВО 27.03.01(02)

<u>доц., к.т.н.</u> (должность, уч. степень, звание)	 (подпись, дата)	23.06.2022	<u>А.С. Степашкина</u> (инициалы, фамилия)
--	---	------------	---

Заместитель директора института ФПТИ по методической работе

<u>доц., к.т.н.</u> (должность, уч. степень, звание)	 (подпись, дата)	23.06.2022	<u>Р.Н. Целмс</u> (инициалы, фамилия)
--	--	------------	--

Аннотация

Дисциплина «Методы исследования с использованием сканирующей зондовой микроскопии» входит в образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 27.03.01 «Стандартизация и метрология» направленности «Цифровая метрология и стандартизация». Дисциплина реализуется кафедрой «№6».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-1 «Способен проводить анализ состояния метрологического обеспечения в подразделении метрологической службы организации»

ПК-3 «Способен осуществлять работы по выявлению и предотвращению несоответствий продукции предъявляемым требованиям»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами исследования физических, физико-химических и геометрических параметров и характеристик твердотельных и молекулярных структур. Эти методы и средства диагностики широко входят в практику исследования и изучения нанообъектов, обладают высоким разрешением, поэтому реально позволяют проводить исследования нанообъектов на атомарном уровне, вплоть до визуализации самой структуры объектов.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Язык обучения по дисциплине: русский

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Целью преподавания дисциплины является получение студентами необходимых знаний в сфере высоких технологий связанных с прикладными исследованиями конструированием и практическим использованием материалов и веществ на атомном и молекулярном уровнях, а также средствах, методов и методик исследования физических, физико-химических и геометрических параметров и характеристик твердотельных и молекулярных объектов. При этом особое внимание уделено изучению особенностей высокоразрешающих методов исследований молекулярных объектов, обеспечивающих получение наиболее полной информации об основных свойствах и характеристиках и протекающих в них процессах.

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональные компетенции	ПК-1 Способен проводить анализ состояния метрологического обеспечения в подразделении метрологической службы организации	ПК-1.3.3 знать область применения методов измерения ПК-1.3.4 знать конструктивные особенности и принципы работы средств измерения, технологические возможности в области применения средств измерения
Профессиональные компетенции	ПК-3 Способен осуществлять работы по выявлению и предотвращению несоответствий продукции предъявляемым требованиям	ПК-3.3.3 знать физические принципы работы, возможности и области применения методов и средств измерений ПК-3.У.3 уметь выбирать и разрабатывать методы и средства контроля технологического процесса, технологической операции, разрабатывать схемы измерений и контроля

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- физические основы измерений и эталоны единиц;
- методы и средства измерений, испытаний и контроля;
- основы информатизации измерений;
- основы электротехники и радиотехники;
- основы моделирование систем и процессов;

- прикладная и законодательная метрология;
- общая теория измерений

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин:

- - цифровые методы и средства измерений;
- - производственная практика;
- - производственная преддипломная практика.

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин:

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин:

- цифровые методы и средства измерений;
- производственная практика;
- производственная преддипломная практика.

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№8
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)	3/ 108	3/ 108
Из них часов практической подготовки	10	10
Аудиторные занятия, всего час.	20	20
в том числе:		
лекции (Л), (час)	10	10
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	10	10
Самостоятельная работа, всего (час)	88	88
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Зачет	Зачет

Примечание: ** кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 8					
Раздел 1. Характеристика концепций нанотехнологий					
Тема 1.1. Характеристика концепций наноструктурных и молекулярных нанотехнологий.	2	2			18

Раздел 2. Методы исследования нанообъектов Тема 2.1. Сведения об объектах исследования, методы исследования, получения и применения наноструктур	2	2			16
Раздел 3. . Основные гетерогенные процессы формирования наноструктурированных объектов Тема 3.1 Характеристика, свойства, процессы формирования наноструктур	2	2			20
Раздел 4. Принципы построения технических средств исследования наноструктур Тема 4.1 Основы механики и конструкций средств исследования наноструктурированных объектов	2	2			18
Раздел 5 Сканирующая туннельная микроскопия Тема 5.1 Туннельный эффект и сканирующая туннельная микроскопия. Особенности работы с электронным микроскопом	2	2			16
Итого в семестре:	10	10			88
Итого	10	10	0	0	88

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
Раздел 1	<p>Тема 1.1 Характеристика концепций наноструктурных и молекулярных нанотехнологий</p> <p>Идею о том, что возможно создавать нужные нам устройства и другие объекты, собирая их "молекула за молекулой" и, даже, "атом за атомом" обычно возводят к знаменитой лекции одного из крупнейших физиков XX века Ричарда Фейнмана «Там внизу — много места». Эта лекция была прочитана им в 1959 году; большинство современников восприняли её как фантастику или шутку.</p> <p>Современный вид идеи молекулярной нанотехнологии начали приобретать в 80-е годы XX века в результате работ К. Э. Дрексlera, которые также сначала воспринимались как научная фантастика. При этом фундаментальная монография "Наносистемы. Молекулярная техника, производство и вычисления" имеет, несомненно, основополагающее значение. Сам термин нанотехнология стал популярен именно после выхода в свет знаменитой книги Э. Дрексlera "Машины творения" и последовавшей за этим дискуссии. Позже Дрекслер в своих научных работах стал использовать термин молекулярная нанотехнология (МНТ) для различения</p>

	<p>предлагаемых им решений.</p> <p>Оценки параметров наномеханических устройств и машин - в своих работах Э. Дрекслер и его последователи оценивали параметры в основном механических устройств, которые они могли бы иметь при приближении размера компонент к молекулярному масштабу. Это обусловлено не тем, что они недооценивают важность электрических, оптических и т. д. эффектов, а тем, что механические конструкции гораздо проще и достовернее масштабируются. При этом осознаётся, что электрические и прочие эффекты могут дать значительные дополнительные возможности. Произведя соответствующее масштабирование Дрекслер получил следующие численные оценки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - позиционирование реагирующих молекул с точностью ~0.1 нм; - механосинтез с производительностью ~10⁶ опер/сек на устройство; - молекулярная сборка объекта массой 1 кг за ~10⁴ сек; - работа наномеханического устройства с частотой ~10⁹ Гц. <p>Другим важным направлением изучения являются объекты наномолекулярной технологии - исследования по вопросам возможного функционирования работы "устройства" аналогичного масштаба в живых организмах. В качестве примера целесообразно рассмотреть работу представителя живого организма АТФ-синтаза являющего ферментом, преобразующим разность концентраций протонов по разные стороны мембраны в энергию, запасённую в молекулах аденозинтрифосфата (АТФ). Последнее используется практически всеми механизмами клетки в качестве универсального носителя энергии. АТФ-синтаза присутствует в "энергетических станциях" растительных и животных клеток - хлоропластах и митохондриях и представляет собой довольно сложную конструкцию из нескольких типов единиц - белковых молекул.</p>
<p>Раздел 2</p>	<p>. Методы исследования нанообъектов Тема 2.1. Общие сведения об объектах исследования в области нанотехнологий</p> <p>Одними из первых инструментов, которые помогли инициировать идеи нанотехнологий, были так называемые сканирующие зонды. Все типы сканирующих зондов были разработаны в Цюрихе в начале 80-х годов. Сама идея очень проста: если, к примеру, провести пальцем по поверхности, то легко отличить бархат от стали или дерева. В данном эксперименте палец действует как структура измерения</p>

	<p>силы. Данная идея и положена в основу работы сканирующего микроскопа, одного из распространенных сканирующих зондов. Сканирующий зонд при измерении скользит по поверхности так же, как это делают пальцы. Зонд имеет наноскопический размер (часто всего один атом). При движении он может определять несколько различных свойств, каждое из которых соответствует иному измерению.</p> <p>Атомно-силовой микроскоп</p> <p>В атомно-силовом микроскопе электроника используется для измерения силы вводимой кончиком зонда при его движении вдоль поверхности исследуемого объекта.</p> <p>Туннельный микроскоп.</p> <p>В туннельном микроскопе измеряется величина электрического тока, проходящего между сканирующим зондом и поверхностью. Туннельная микроскопия – это практически первый разработанный метод зондового сканирования, нашедшего широкое применение.</p> <p>Магнитно-силовой микроскоп</p> <p>В магнитно-силовом микроскопе зонд, сканирующий поверхность, является магнитным, он позволяет почувствовать на поверхности локальную магнитную структуру. Зонд магнитно-силового микроскопа работает подобно считывающей головки винчестера или магнитофона. Сканирующие микроскопы позволили впервые увидеть объекты размером с атом.</p>
<p>Раздел 3</p>	<p>Тема 3.1 Свойства процессов формирования наноструктур</p> <p>В общем случае под гетерогенными процессами понимают технологические процессы, происходящие на границе раздела фаз и формирующие гетерогенные системы. Гетерогенная система представляет собой термодинамическую систему, состоящую из различных по физическим и химическим свойствам частей или фаз, которые отделены друг от друга поверхностями раздела. Каждая из фаз при этом гомогенна и ее поведение подчиняется законам термодинамики.</p> <p>а) Химические гетерогенные процессы.</p> <p>Многие гетерогенные процессы не связаны с химическими реакциями и основаны только на физико-химических явлениях. Химические гетерогенные процессы включают в качестве этапа химические реакции, которые идут в одной из фаз после перемещения туда реагентов или на поверхности раздела фаз. На гетерогенные равновесия влияют температура, давление, концентрации реагентов и продуктов реакции. Равновесие гетерогенных процессов</p>

	<p>определяется константой равновесия химических реакций, законом распределения компонентов между фазами и правилом фаз. Равновесные концентрации компонентов в соприкасающихся фазах определяются законом распределения вещества, который устанавливает постоянное соотношение между равновесными концентрациями вещества в двух фазах системы при определенной температуре. Гетерогенные процессы</p> <p>б) Свойства гетерогенных процессов</p> <p>Механизм гетерогенных процессов сложнее гомогенных, так как взаимодействию реагентов, находящихся в разных фазах, предшествует их доставка к поверхности раздела фаз и массообмен между фазами. Поэтому скорость гетерогенных некаталитических процессов, как правило, меньше скорости гомогенных процессов. Массообмен между фазами осуществляется с помощью диффузии и характеризуется коэффициентом массообмена где D — коэффициент диффузии, δ - толщина пограничного слоя. Для расчета β, который служит описательной характеристикой и для более сложных механизмов переноса, используют критериальные уравнения. $\beta = D / \delta$ в период протекания гетерогенного процесса.</p>
<p>Раздел 4</p>	<p>4.1 Основы механики и конструкций средств исследования</p> <p>а) Областью применения наноструктурированных объектов является нанообъекты, размеры которых находятся в диапазоне от 0,1 до 100 нм. Этот диапазон принято называть <i>наномасштабом</i>. Согласно проекту Технической спецификации ISO/DTS 12805 произведенные нанообъекты разделяют по признаку геометрической формы на три категории: частицы - объекты, имеющие три размера в наномасштабе; волокна - объекты, имеющие два размера в наномасштабе; пластины - объекты, имеющие один размер в наномасштабе.</p> <p>Большинство нанообъектов имеет углеродную основу. Долгие годы считалось, что углерод может образовывать только две аллотропные кристаллические структуры - алмаз и графит. Аллотропия - существование одного и того же химического элемента в несхожих формах. Однако в последние годы были обнаружены еще две аллотропные формы углерода, имеющие большую перспективу использования в нанотехнологиях.</p> <p>б) Свойства острейного зондового датчика.</p> <p>Одним из объектов нанометрологии является острейный зондовый датчик, используемый в</p>

сканирующей зондовой микроскопии для исследования размеров и свойств поверхности нанообъектов. Датчик состоит из полупроводникового кристалла (чипа), гибкой консоли (собственно кантилевера) и твердотельного зонда (иглы). Обычно этот датчик называют кантилевером.

Геометрически зонд представляет собой иглу конической или призматической формы с углом при вершине 20 - 25° и высотой около 10 мкм. Наиболее важная характеристика зонда - радиус закругления острия r , значение которого обычно не более 1 - 25 нм. Величина радиуса r влияет на размеры области предельно достижимого разрешения. Сложность изготовления зонда существенно увеличивается с уменьшением радиуса острия.

в) технические характеристики датчика наноперемещений

В качестве измерительных преобразователей в нанотехнологии используется датчик наноперемещений, представляющий собой совокупность механического элемента и транзистора. Механическим элементом является брусок (наноэлектромеханическая перемычка) из арсенида галлия, закрепленный с обоих концов. Размеры бруска: длина 3 мкм, ширина 250 нм, толщина 200 нм. Детектор перемещения - одноэлектронный транзистор - расположен на расстоянии 250 нм от бруска. Транзистор электрически соединен с бруском через емкость. Внешнее напряжение, приложенное к бруску, заставляет его вибрировать. При перемещении бруска относительно детектора изменяется ток, протекающий через транзистор.

г) Назначение датчика силы и массы

В датчике силы и массы в качестве первичного измерительного преобразователя использована однослойная углеродная нанотрубка диаметром 1 - 4 нм, расположенная между двумя золотыми электродами. Размеры канавки, через которую протянута нанотрубка: ширина 500 нм, длина 1,5 мкм. Большая упругость углеродной нанотрубки позволяет ей колебаться в широком диапазоне частот (от 3 до 200 МГц). Она может также работать в качестве транзистора, что позволяет определять частоту ее колебаний и смещение относительно положения покоя. Устройство работает в вакууме, поскольку на воздухе большое число молекул будет сталкиваться с нанотрубкой или даже абсорбироваться на ней. В зависимости от воздействия внешней силы на измерительный преобразователь он изменяет свое положение. Достигнутая чувствительность устройства позволяет измерять смещение в 0,5 нм.

д) Сфера применения зондового датчика

Зондовый датчик устройство, включающее твердотельный острый зонд, гибкую пружинную

	<p>консоль - кантилевер (англ. <i>cantilever</i> - консоль) и кристалл (держатель). В литературе это устройство нередко называют просто «кантилевером». Изгиб кантилевера с зондом регистрируется обычно с помощью отраженного лазерного пучка света и фотоприемника. Разрешающая способность сканирующих зондовых микроскопов определяется следующими параметрами кантилевера: радиус закругления острия иглы; высота иглы, аспектное соотношение иглы, характеризуемое углом конуса; у наиболее совершенных кантилеверов аспектное соотношение достигает величины 15:1. Для изготовления кантилеверов используются полупроводниковые пластины (например, КДБ-12: кремний <i>p</i>-типа ориентации $\square 100$). Роль изолирующего слоя выполняет диоксид кремния SiO_2. Консоль кантилевера формируется электрохимическим травлением в подогретом растворе щелочи КОН. В процессе травления заготовка медленно поднимается из раствора щелочи для получения конической (или призматической) формы иглы с острым концом.</p> <p>Промышленностью освоены в серийном производстве десятки видов конструкции кантилеверов. Они выпускаются с одной, двумя, тремя или четырьмя консолями. Консоль может быть в плане прямоугольной или треугольной, длинной или короткой, с покрытием или без покрытия. Радиус закругления иглы зонда - от 1 до 25 нм..</p>
<p>Раздел 5</p>	<p>Тема 5.1. Туннельный эффект и сканирующая туннельная микроскопия</p> <p>а) Физический смысл туннельного эффекта</p> <p>Физический смысл туннельного эффекта заключается в прохождении через потенциальный барьер электрона (микрочастицы), энергия которой меньше, чем высота барьера. Строгое объяснение этого эффекта дает квантовая механика (исходя из неопределенности импульса микрочастицы в области барьера). Еще в XVII в. И. Ньютон сформулировал законы классической механики, что стало великим событием в истории физики. Это объясняется «волновой природой» электронов, а само название возникло из-за того, что, с точки зрения внешнего наблюдателя классической физики (и здравого смысла!), эффект выглядит совершенно непонятным и напоминает ситуацию, при которой электрон как бы находит в стене какой-то «туннель» и проскакивает через него (в качестве стены выступает электростатический потенциал ядра).</p> <p>б) Практическое применение туннельного эффекта</p> <p>Туннельный эффект уже давно весьма эффективно</p>

	<p>используется в науке и технике. В частности, на нем основан принцип действия известных туннельных диодов и многих других полупроводниковых приборов. В настоящее время эффект широко применяется в сверхчувствительных записывающих головках магнитных дисков, сканирующих туннельных микроскопах, приборах ядерной физики и т.д. Процесс носит случайный характер, но его вероятность может быть вычислена по законам квантовой механики совершенно точно (при этом электрон рассматривается одновременно и в качестве волны, и в качестве частицы). Именно волновые характеристики поведения электрона позволяют ему преодолевать энергетический барьер. При большом количестве таких электронов можно, естественно, говорить о туннельном токе.</p> <p>в) В туннельном микроскопе измеряется величина электрического тока, проходящего между сканирующим зондом и поверхностью. В зависимости от того, как проводятся измерения, микроскоп можно использовать либо для проверки локальной геометрии (насколько поверхность локально выступает вперед), либо для измерения локальных характеристик электропроводности. Туннельная микроскопия — это, по сути, первый разработанный метод зондового сканирования, и за его открытие Г. Бинниг (G. Binnig) и Г. Рорер (H. Rohrer) в 1986 г. получили Нобелевскую премию.</p>
--	---

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр 8					
1	Основные черты современных ИТ. Структурированность стандартов цифрового обмена данными алгоритмов	Анализ и оценка ресурсов, необходимых для управления информацией, ПО, необходимое для создания, хранения, управления, передачи и поиска информации	2	1	1
2	Основные черты современных ИТ. Структурированность стандартов цифрового обмена данными алгоритмов	Анализ и оценка ресурсов, необходимых для управления информацией, ПО, необходимое для	2	1	2

		создания, хранения, управления, передачи и поиска информации			
3	Исследование поверхности методом атомно-силовой микроскопии	Обработка результатов исследования образца и анализ результатов измерений	2	1	4
4	Подготовка электронного микроскопа и функциональных блоков (узлов) к работе в основных рабочих режимах	Порядок и последовательность включения и выключения СЗМ мод. Solver PRO-M	2	1	5
51	Порядок проведения поверки туннельного и сканирующего микроскопов	Последовательность проведения поверки эл. микроскопа мод. Solver PRO-M	2	1	5
Всего			10	5	

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				
Всего				

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 8, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	44	44
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	18	18

Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	26	26
Всего:	88	88

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий
Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.
Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
https://www.booktech.ru/books/nanotehnologii	Физические основы микро- и наноэлектроники, Дурнаков А.А., /учебное пособие/, УрФУ, 2020, - 252 с.	
https://obuchalka.org/knigi-po-nanotehnologiyam	Физические основы нанотехнологий и наноматериалы, Смирнов В.И. /учебное пособие/, Ульяновск, УлГТУ, 2017, 240 с.	
https://obuchalka.org/knigi-po-nanotehnologiyam	Базовые технологии микро- и наноэлектроники: Воротынцев В.М., Скупов В.Д., -М, , Проспект, 2017, -519 с.	
https://obuchalka.org/knigi-po-nanotehnologiyam	Материалы и методы нанотехнологий, Старостин В.В. /учебное пособие/, -М, Бином, 2016, -431с.	
https://obuchalka.org/knigi-po-nanotehnologiyam	Наноматериалы: учебное пособие/, Д.И. Рыжонков, В.В. Лёвина, Э.Л. Дзидзигури, -М, Бином, 2017, -343 с.	
https://obuchalka.org/knigi-po-nanotehnologiyam	Вычислительные	

	нанотехнологии, Попов А.М., /учебное пособие/, Кно-Рус, 2017, -126 с.	
https://znanium.com/catalog/product/1032129 (дата обращения: 07.09.2021). – Режим доступа: по подписке.	Исаев, С.В. Интеллектуальные системы : учеб. пособие / С.В. Исаев, О.С. Исаева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. - 120 с. - ISBN 978-5-7638-3781-0.	
https://znanium.com/catalog/product/1060845 (дата обращения: 07.09.2021). – Режим доступа: по подписке.	Одинцов, Б. Е. Модели и проблемы интеллектуальных систем : монография / Б.Е. Одинцов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 219 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1060845. - ISBN 978-5-16-015839-6.	
https://fs.guap.ru/science/patents/2021612957.pdf	Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021612957 Дом качества «QFD» Правообладатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (RU) Автор: Чабаненко Александр Валерьевич (RU)	

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
http://science.guap.ru	Научная и инновационная деятельность ГУАП
http://www.consultant.ru	Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
http://www.garant.ru	Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»
http://list-of-lit.ru/nano/nnotechnologii	Список литературы по нанотехнологии

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1	Лекционная аудитория	
2	Лаборатория искусственного интеллекта и цифровых технологий в метрологии	13-13

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Зачет	Список вопросов; Тесты;

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции 5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций
«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; – уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; – опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; – умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; – делает выводы и обобщения; – свободно владеет системой специализированных понятий.
«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; – не допускает существенных неточностей; – увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; – аргументирует научные положения; – делает выводы и обобщения; – владеет системой специализированных понятий.
«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; – допускает несущественные ошибки и неточности; – испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; – слабо аргументирует научные положения; – затрудняется в формулировании выводов и обобщений; – частично владеет системой специализированных понятий.
«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся не усвоил значительной части программного материала; – допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; – испытывает трудности в практическом применении знаний; – не может аргументировать научные положения; – не формулирует выводов и обобщений.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Вопросы для зачета представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Вопросы для зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
1	Основные положения лекции, прочитанной Р. Фейнманом в 1959 г.	ПК-1.3.3
2	Где и в какой области промышленного производства впервые стали реализовывать идеи нанотехнологий?	ПК-1.3.4
3	Особенности наноразмерных величин и их количественные значения.	ПК-3.3.3
4	Работы академика Ж.И. Алферова в области нанотехнологий	ПК-3.У.3
5	Принципы самосборки, присущие наиболее распространенным объектам нанотехнологий	ПК-1.3.3
6	Использование самоорганизации в НТ. Основные свойства самоорганизующихся систем	ПК-1.3.4
7	Наноматериалы, наименования, назначение, основные определения, какие объекты к ним относятся?	ПК-1.3.3
8	Основные типы наноматериалов, разделение по признакам измерений и размерности	ПК-1.3.3
9	Основы классификации и типы структур наноматериалов	ПК-1.3.3
10	Основные категории наноматериалов	ПК-1.3.3
11	Особенности свойств наноматериалов, направления их использования	ПК-1.3.3
12	Основные области применения объектов наноструктурных объектов	ПК-1.3.3
13	Краткая характеристика конструкционных, инструментальных и износостойких материалов	ПК-1.3.4
14	Использование наноматериалов в электронной технике Назначение, краткая характеристика электронного микроскопа	ПК-1.3.3
15	Физический смысл свойств ЭМ: увеличение, разрешение, разрешающая способность.	ПК-1.3.4
16	Условия формирования и свойства электронного луча микроскопа	ПК-1.3.3
17	Физический смысл хроматической аберрации	ПК-1.3.3
18	В чем различие характеристик разрешения оптического и	ПК-1.3.3

	электронного микроскопов	
19	Характеристика разрешающей способности ЭМ	ПК-1.3.4
20	Принцип работы и устройство системы изображения ЭМ	ПК-1.3.4

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

№ п/п	Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы
	Учебным планом не предусмотрено

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов	Код индикатора
	<p>1. Исследование микро- и наноструктур. . Начало вопроса: Какие методы диагностики наиболее распространены для исследования физических параметров и характеристик нанообъектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - электронная микроскопия высокого разрешения; - отражательная электронная микроскопия; - микроскопия медленных электронов.; - оптическая микроскопия. <p>2. Важнейшие технологические достижения во второй половине двадцатого столетия. Начало вопроса: Что способствовало, в наибольшей степени, интенсивному развитию нанотехнологий в стране и за рубежом? Начало вопроса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технология создания электровакуумных приборов; - создание микромодульных элементов; - создание интегральных печатных плат; - создание полупроводниковых элементов электронной техники. <p>3. Физическая сущность закона Гордона Мура. Начало вопроса: В чем заключается смысл эмпирического закона Мура?</p> <ul style="list-style-type: none"> - объясняют принцип получения черно-белого изображения кадра телевизора; - закон объясняет принцип функционирования оптоволоконного элемента; - предельные границы быстродействия компьютера; - предельное число размещения транзисторов на печатной плате компьютера. <p>4. Средства измерения для исследования наноструктур. Начало вопроса: В чем заключается основные достоинства электронного микроскопа?</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены весовые и габаритные характеристики приборов, - возможность цифрового представления результатов анализа; - более совершенная, по сравнению с оптическим микроскопом, 	ПК-1.3.3, ПК-1.3.4

система получения изображения наблюдаемого объекта;

- возможность получения более разнообразной информации об объекте;
- пределы увеличения исследуемого объекта.

5. Основные параметры и характеристики микроскопов.
Начало вопроса: Назовите предельные значения характеристики увеличения оптического микроскопа:

- 100 раз;
- 200 раз;
- 400 раз;
- 700 раз;
- 1000 раз;
- 1500 раз

6. Основные параметры и характеристики микроскопов.
Начало вопроса: Предельные значения увеличения электронного микроскопа:

- 1000 раз;
- 2000 раз;
- 5000 раз;
- 8000 раз;
- 1млн. раз;
- 2 млн. раз

7. Основные параметры и характеристики микроскопов.
Начало вопроса: Чем определяется разрешающая способность оптического микроскопа:

- уровнем освещенности рабочей линзы;
- величиной фокусного расстояния;
- совершенством отклоняющей системы;
- длиной волны света.

8. Основные параметры и характеристики микроскопов.
Начало вопроса: Чем определяется разрешающая способность электронного микроскопа:

- конструкцией системы изображения микроскопа;
- устройством электронной пушки;
- системой считывания результатов обработки измерений;
- расстоянием пролета электрона;
- скоростью пролета электрона.

9. Преимущества электронного микроскопа.
Начало вопроса: Чем объясняется высокая разрешающая способность электронного микроскопа:

- геометрическими размерами рабочей зоны;
- использованием электронного потока вместо светового потока;
- длиной волны электрона.

10. Основные параметры и характеристики электронных микроскопов.
Начало вопроса: От чего зависит величина волны электронного потока в микроскопе:

- габариты рабочей зоны;
- величиной напряжения на аноде;
- конструкцией системы изображения микроскопа;
- архитектуры отклоняющей системы микроскопа

11. Какая серия стандартов в настоящее время является основной

	<p>для стандартов из области ИТ?</p> <p>a. серия 25000; b. серия 9000; c. серия 14000; d. серия 16000.</p> <p>12. Выделите два основных стандарта в области ИТ.</p> <p>a. 12207:1995; b. 19760:2003; c. 16326:1999; d. 90003:2004; e. 15288:2002.</p> <p>13. Назовите аббревиатуру международного союза электросвязи:</p> <p>a. IEEE; b. IEC; c. ITU; d. ISO.</p>	
--	---	--

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
	Не предусмотрено

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;

- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);

- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Структура предоставления лекционного материала:

- лекции согласно разделам (табл.3) и темам (табл.4).

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимися практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;

- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Требования к проведению практических занятий

Практические занятия проводятся в следующих формах:

- моделирование ситуаций применительно к профилю профессиональной деятельности обучающихся;

- решение ситуационных задач

- групповая дискуссия.

Преподаватель при проведении занятий выполняет функцию консультанта, который направляет коллективную работу студентов на принятие правильного решения. Занятие осуществляется в диалоговом режиме, основными субъектами которого являются студенты.

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине;

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

Студент после выполнения, сдачи и защиты практических работ допускается к собеседованию при прохождении аттестации в форме экзамена.

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

– экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Система оценок при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с руководящим документом организации РДО ГУАП. СМК 3.76 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в ГУАП» https://docs.guap.ru/guap/2020/sto_smk-3-76.pdf.

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой